

SK 海力士宣布 HBM2E 内存：带宽最高 460GB/s、容量翻番单颗 16GB

来源：快科技

SK 海力士宣布，已经成功研发出新一代 DRAM 内存“HBM2E”，可视为 HBM2 的增强版，拥有业界最高的传输带宽，相比现在的 HBM2 提升了大约 50%，同时容量也翻了一番。

SK 海力士的 HBM2E 每个针脚传输速率为 3.6Gbps，搭配 1024-bit 位宽的话可以提供超过 460GB/s 的超高带宽，无可比拟。

AMD Radeon VII 显卡曾经率先实现 1TB/s 的显存带宽，但应用了 4096-bit 的位宽，如果换成 HBM2E 总带宽可以轻松超过 1.8TB/s。

同时得益于 TSV 硅通孔技术，HBM2E 内存可以最多垂直堆叠八颗 16Gb 芯片，单颗封装总容量因此可达 16GB，是目前的两倍。

SK 海力士表示，超高带宽的 HBM2E 可用于工业 4.0、高端 GPU 显卡、超级计算机、机器学习、AI 人工智能等各种尖端领域。而且不同于传统 DRAM 必须单独封装、占用主板面积，HBM 系列可以与 GPU 芯片、逻辑芯片等整合封装在一起，彼此距离可以做到仅仅几个微米，大大节省整体面积，也能保证更快的数据传输。

文章收入时间：2019-08-12